

## Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Мурашев Виктор Николаевич
2	Дата рождения (полная)	24 июля 1947
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников, материалов и приборов электронной техники)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	Профессор
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4. <a href="https://misis.ru">https://misis.ru</a>
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
	Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования
	Тип организации	Высшее Учебное Заведение
	Наименование подразделения	Кафедра материаловедения полупроводников и диэлектриков
	Должность	Профессор
7	Основные публикации в области диссертационного исследования	
	<p>1. A.A. Krasnov, V.V. Starkov, S.A. Legotin, O.I. Rabinovich, S.I. Didenko, V.N. Murashev, V.V. Cheverikin, E.B. Yakimov, N.A. Fedulova, B.I. Rogozev, B.I. Rogozev, A.S. Laryushkin, Development of betavoltaic cell technology production based on microchannel silicon and its electrical parameters evaluation, Appl. Radiat. Isot. 121 (2017) 71–75. <a href="https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.12.019">https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.12.019</a>.</p> <p>2. A.A. Krasnov, S.A. Legotin, V.N. Murashev, S.I. Didenko, O.I. Rabinovich, S.Y. Yurchuk, Y.K. Omelchenko, E.B. Yakimov, V.V. Starkov, Development and investigation of silicon converter beta radiation <math>^{63}\text{Ni}</math> isotope, in: IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 2016. <a href="https://doi.org/10.1088/1757-899X/110/1/012029">https://doi.org/10.1088/1757-899X/110/1/012029</a>.</p> <p>3. Y.S. Nagornov, V.N. Murashev, Simulation of the <math>\beta</math>-voltaic effect in silicon pin structures irradiated with electrons from a nickel-63 <math>\beta</math> source, Semiconductors. 50 (2016) 16–21. <a href="https://doi.org/10.1134/S1063782616010188">https://doi.org/10.1134/S1063782616010188</a>.</p> <p>4. S.U. Urchuk, V.N. Murashev, S.A. Legotin, A.A. Krasnov, O.I. Rabinovich, K.A. Kuzmina, Y.K. Omel'Chenko, U.V. Osipov, S.I. Didenko, Betavoltaic p--n+-structure simulation, in: J. Phys. Conf. Ser., 2016. <a href="https://doi.org/10.1088/1742-6596/741/1/012094">https://doi.org/10.1088/1742-6596/741/1/012094</a>.</p> <p>5. O. Abdullaev, M. Mezheny, A. Chelny, A. Savchuk, Y. Ahmerov, O. Rabinovich, V. Murashev, S. Didenko, Y. Osipov, S. Sizov, M. Orlova, A. Aluyev, MOCVD growth GaN on sapphire, in: IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., 2019. <a href="https://doi.org/10.1088/1757-899X/617/1/012015">https://doi.org/10.1088/1757-899X/617/1/012015</a>.</p> <p>6. O. Orlov, V. Murashev, A. Lebedev, V. Orlov, S. Ivanov, Features of the improving of the <math>\text{HfO}_2</math> ReRAM cells characteristics reproducibility, in: Proc. 2019 IEEE Conf. Russ. Young Res. Electr. Electron. Eng. ElConRus 2019, 2019: pp. 2087–2089. <a href="https://doi.org/10.1109/ElConRus.2019.8657230">https://doi.org/10.1109/ElConRus.2019.8657230</a>.</p> <p>A. Aluyev, Y. Akhmerov, N. Kourova, V. Logachev, M. Mezheny, A. Chelny, A.</p>	

Savchuk, V. Murashev, O. Rabinovich, S. Didenko, Chromaticity coordinates temperature dependence for blue laser diodes for solid state laser lighting, in: J. Phys. Conf. Ser., 2018. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1124/4/041032>.

7. A. Savchuk, Y. Akhmerov, A. Chelny, O. Abdullaev, O. Rabinovich, M. Mezheny, A. Zharkova, A. Aluyev, M. Zakusov, N. Kourova, V. Murashev, S. Didenko, Structure of V-defects in a-GaN films grown on r-sapphire substrate, in: J. Phys. Conf. Ser., 2019. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1410/1/012022>.

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты